

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2016104907, 16.07.2014

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
16.07.2013 GB 1312698.2

(43) Дата публикации заявки: 21.08.2017 Бюл. № 24

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 16.02.2016(86) Заявка РСТ:
GB 2014/052170 (16.07.2014)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2015/008063 (22.01.2015)Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б.Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"(71) Заявитель(и):
**ХЕЙДЭЙЛ ГРАФИН ИНДАСТРИЗ
ПиЭлСи (GB)**(72) Автор(ы):
ТАРАТ Афшин (GB)

(54) ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА

(57) Формула изобретения

1. Способ получения кристаллов слоистого оксоацетата цинка (LBZA) из реакционного раствора, содержащего ионы цинка, ацетат-ионы и основное соединение, причем:

ацетат-ион является единственным противоионом цинка в реакционном растворе; и/или

основное соединение является гидроксиалкиламином; и/или

основное соединение является первым основным соединением, и реакционный раствор дополнительно содержит второе основное соединение, имеющее более высокий рKa, чем первое основное соединение.

2. Способ по п. 1, в котором ацетат цинка является единственным соединением цинка, используемым для образования реакционного раствора.

3. Способ по п. 1, в котором ацетат-ион является единственным противоионом цинка в реакционном растворе, и основное соединение является гидроксиалкиламином.

4. Способ по п. 1, в котором основное соединение является трис(гидроксиметил)метиламином.

5. Способ по п. 1, в котором реакционный раствор образуют путем растворения ацетата цинка в воде.

6. Способ по п. 5, в котором концентрация ацетата цинка составляет от 0,01 до 0,3М.

7. Способ по п. 1, в котором основное соединение имеет рKa ≤ 9 при 25°C.

RU 2016104907 A

RU 2016104907 A

8. Способ по п. 1, в котором основное соединение является первым основным соединением, и реакционный раствор дополнительно содержит второе основное соединение, имеющее более высокий рК_a, чем первое основное соединение, и при этом второе основное соединение добавляют к реакционному раствору после первого основного соединения.

9. Способ по п. 1, в котором основное соединение является первым основным соединением, и реакционный раствор дополнительно содержит второе основное соединение, имеющее более высокий рК_a, чем первое основное соединение, причем второе основное соединение является гидроксиалкиламином.

10. Способ по п. 9, в котором второе основное соединение является этаноламином.

11. Способ по п. 1, в котором реакционный раствор имеет pH от 5,2 до 7,3.

12. Способ по п. 1, в котором реакционный раствор имеет pH от 5,7 до 6,7.

13. Способ по п. 1, в котором реакционный раствор имеет pH от 6,1 до 6,3.

14. Способ по п. 1, содержащий подвергание реакционного раствора облучению микроволнами.

15. Способ по п. 14, в котором кристаллы LBZA являются нанолистами.

16. Способ по п. 1, содержащий выстаивание реакционного раствора.

17. Способ по п. 16, в котором реакционный раствор выстаивают при ≤ 75°C.

18. Способ по п. 17, в котором реакционный раствор выстаивают при ≤ 40°C.

19. Способ по п. 16, в котором кристаллы LBZA являются нанолентами.

20. Способ изготовления материала ZnO, содержащий получение кристаллов LBZA способом по любому из пп. 1-19, а затем пиролитическое разложение кристаллов LBZA.

21. Способ изготовления электронного или полупроводникового компонента, содержащий изготовление материала ZnO способом по п. 20 и встраивание этого материала в электронный или полупроводниковый компонент.

22. Кристалл LBZA, получаемый способом по любому из пп. 1-19.

23. Материал ZnO, получаемый способом по п. 20.